

弊社では、お客様からのご要望に合わせて熱処理を行っております。SiCのデバイス作製に適した高温イオン注入、キャップ膜成膜や高温アニール処理といった一連の処理を弊社で行うことが可能です。

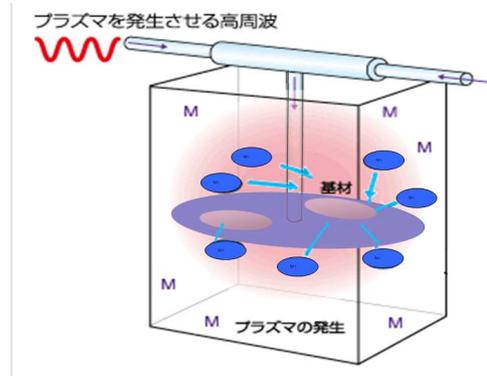
高温イオン注入

600℃までの高温注入
小片～6inchサイズに対応
注入ダメージ軽減に有効



キャップ膜成膜

C₂H₂を反応させ、DLC膜を成膜
小片～6inchサイズに対応
アニール処理による表面荒れの緩和に有効



高温アニール処理

最大1800℃のアニール処理
小片～6inchサイズに対応
様々な化合物半導体へ対応

